

您现在的位置：首页>新闻中心>新闻快递

## 邹世昌院士率团访问美国范德堡大学

2011年08月18日 浏览次数

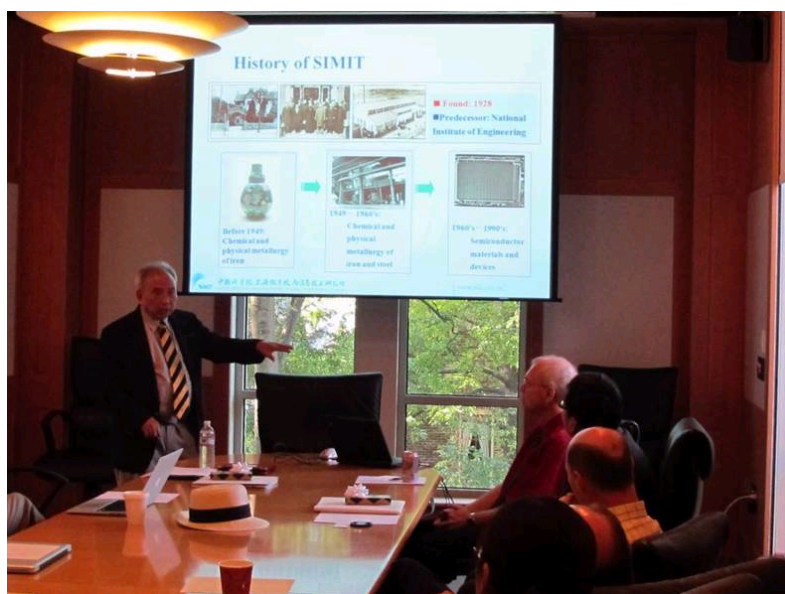
应美国范德堡大学（Vanderbilt University）电子与计算机科学系主任Dan Fleetwood教授邀请，微系统所邹世昌院士于8月初高温假期间率领微系统所代表团访问该校。范德堡大学工程学院院长Ken Galloway教授、空间电子研究所所长Ron Schrimpf教授、Robert Reed教授、Robert Weller教授、张恩霞博士等接待了代表团。

访问期间，邹世昌院士介绍了微系统所的发展历史、研究领域和国际合作情况，并代表微系统所颁发聘书，聘请Dan Fleetwood教授和Ron Schrimpf教授为客座教授，毕大炜博士和陈明分别做了题为“TID Effects in 180 nm Embedded Flash Technology”和“TID Enhanced DIBL Effect of Deep submicron NMOSFET”的学术报告，介绍了微系统所在CMOS器件辐射效应方面的最新研究进展；Robert Weller教授和Robert Reed教授分别做了题为“MRED and SEE error rate prediction”和“Soft error model validation”的报告，介绍了范德堡大学在单粒子效应的蒙特卡洛模拟以及软错误预测建模方向的研究情况。

双方探讨了各自在先进材料和器件的总剂量辐射效应、单粒子效应等研究方向的工作基础和研究兴趣，深入挖掘合作潜力，经过讨论，双方一致同意通过人才交流和联合申报课题等方式，深化双方在先进CMOS器件总剂量辐射效应和单粒子效应研究方面的合作。

代表团还在Robert Reed教授和张恩霞博士带领下，参观了该校辐射效应研究实验室，深入了解了其科研设施和人才培养情况。

此次访问加深了范德堡大学和微系统所的相互了解和双方在辐射效应研究方面的合作。



邹院士介绍微系统所情况



邹院士向Dan Fleetwood教授颁发客座教授聘书